

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成26年10月9日(2014.10.9)

【公開番号】特開2013-51340(P2013-51340A)

【公開日】平成25年3月14日(2013.3.14)

【年通号数】公開・登録公報2013-013

【出願番号】特願2011-189231(P2011-189231)

【国際特許分類】

H 01 L 33/08 (2010.01)

【F I】

H 01 L 33/00 1 2 0

【手続補正書】

【提出日】平成26年8月22日(2014.8.22)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0082

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0082】

絶縁層116は、第2クラッド層108上であって、柱状部111の側方(平面視における、柱状部111の周囲)に形成されている。絶縁層116は、柱状部111の側面に接していることができる。絶縁層116の上面は、例えば、コンタクト層110の上面115と連続している。絶縁層116としては、例えば、SiN層、SiO₂層、SiON層、Al₂O₃層、ポリイミド層などを用いることができる。絶縁層116として上記の材料を用いた場合、電極112, 114間の電流は、絶縁層116を避けて、該絶縁層116に挟まれた柱状部111を流れることができる。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0095

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0095】

なお、発光装置100では、出射部181, 186についてもII族またはIXI族の元素が拡散することができる。そのため、出射部181, 186におけるCOD破壊も抑制することができる。

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0135

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0135】

発光装置1000では、基板1102として、GaAs基板を用いた。第1クラッド層1104として、InGaAlP層を用いた。活性層1106として、InGaPウェル層およびInGaAlPバリア層を用いた。第2クラッド層1108として、InGaAlP層を用いた。コンタクト層1110として、GaAs層を用いた。第1電極1112として、Cr層、Auger層、Ni層、Au層の順序で積層したもの用い、基板1102の下面全面に形成した。第2電極1114として、コンタクト層1110側からCr層、AuZn層、Au層の順序で積層したものを用いた。